

а 2017 0092

Изобретение относится к технологии полупроводников и может быть использовано, в частности, в фотоэлектрических преобразователях.

Способ повышения эффективности фото-электрических элементов на основе $p^+InP-pInP-n^+CdS$ включает рост слоя p^-InP на подложке, выполненной в виде платы из p^+InP с кристаллографической ориентацией (100), разориентацией $3...5^\circ$ в направлении (110) и с концентрацией носителей заряда 10^{18} см⁻³, нанесение, на фронтальную часть платы, методом квазизакрытого объема слоя n^+CdS , нанесение на обратную сторону платы омического контакта из $Ag+Zn$, его термическую обработку при температуре $450^\circ C$, нанесение омического контакта из In на слой n^+CdS , его термическую обработку при температуре $250^\circ C$ и нанесение методом пульверизации, при температуре $300^\circ C$, антиотражающего слоя ZnO .

П. формулы: 1